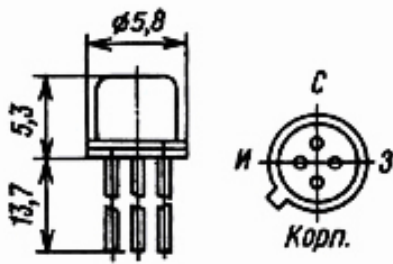


КП303В



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором на основе р-п перехода и каналом n-типа.

Предназначены для применения во входных каскадах усилителей высокой частоты 2П303Д, 2П303Е, 2П303И, КП303Д, КП303Е и низкой 2П303А, 2П303Б, 2П303В, КП303А, КП303Б, КП303В, КП303Ж, КП303И частот с высоким входным сопротивлением.

Транзисторы 2П303Г, КП303Г в основном предназначены для применения в зарядочувствительных усилителях и других устройствах ядерной спектроскопии.

Выпускаются в металлоглазном корпусе с гибкими выводами.

Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 0,5 г.

Основные технические характеристики транзистора КП303В:

- Структура транзистора: с р-п-переходом и n-каналом;
- $R_{си\ max}$ - Рассеиваемая мощность сток-исток: 200 мВт;
- $U_{зи\ отс}$ - Напряжение отсечки транзистора - напряжение между затвором и истоком: 1... 4 В;
- $U_{си\ max}$ - Максимальное напряжение сток-исток: 25 В;
- $U_{зс\ max}$ - Максимальное напряжение затвор-сток: 30 В;
- $U_{зи\ max}$ - Максимальное напряжение затвор-исток: 30 В;
- I_c - Ток стока (постоянный): 20 мА;
- $I_{с\ нач}$ - Начальный ток стока: не более 5 мА;
- $I_{с\ ост}$ - Остаточный ток стока: 5 мА;
- S - Крутизна характеристики: 2... 5 мА/В;
- $C_{11и}$ - Входная емкость транзистора - емкость между затвором и истоком: не более 6 пФ;
- $C_{12и}$ - Емкость обратной связи в схеме с общим истоком при коротком замыкании на входе по переменному току: не более 2 пФ;
- $K_{ш}$ - Коэффициент шума транзистора: не более 20 дБ на частоте 1 кГц